

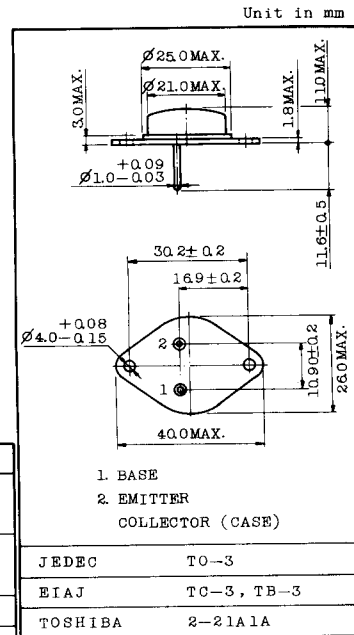
シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

2SB555
2SB556

- 電力増幅用
- Power Amplifier Applications.
- ・ コレクタ損失が大きい。 : $P_C = 100W$ (2SB555, 2SB556)
- ・ 高耐圧です。 : $V_{CE0} = -140V$ (2SB555)
 : $V_{CE0} = -120V$ (2SB556)
- ・ 2SD425, 2SD426 とコンプリメンタリになります。
- ・ 大電力ハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。
 $P_O = 80W$ (2SB555), $P_O = 60W$ (2SB556)
- ・ Complementary to 2SD425 and 2SD426.
- ・ Recommended for High-Power High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース 間電圧	2SB555	-140	V
	2SB556	-120	
コレクタ・エミッタ 間電圧	2SB555	-140	V
	2SB556	-120	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-12	A
エミッタ電流	I_E	12	A
コレクタ損失 (Tc = 25°C)	P_C	100	W
接合温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-65 ~ 150	°C



アクセサリはAC73を適用
MOUNTING KIT No. AC73

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -60V, I_E = 0$	-	-	-100	μA	
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	-	-	-100	μA	
コレクタ・エミッタ 間降伏電圧	2SB555	$I_C = -0.1A, I_B = 0$	-140	-	-	V	
	2SB556		-120	-	-		
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -10mA, I_B = 0$	-5	-	-	V	
直流電流増幅率	h_{FE} (Note)	$V_{CE} = -5V, I_C = -2A$	40	-	140		
コレクタ・エミッタ 間飽和電圧	2SB555	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -7A, I_B = -0.7A$		-	-3.0	V
	2SB556		$I_C = -6A, I_B = -0.6A$		-	-	
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -7A$	-	-	-2.5	V	
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -5V, I_C = -2A$	-	6	-	MHz	
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_B = 0, f = 1MHz$	-	330	-	pF	

Note : h_{FE} 区分 / h_{FE} classification R : 40 ~ 80, O : 70 ~ 140